

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 17 年 9 月 29 日 (2005.9.29)

【公開番号】特開 2003-157978 (P2003-157978A)

【公開日】平成 15 年 5 月 30 日 (2003.5.30)

【出願番号】特願 2002-192850 (P2002-192850)

【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 B 33/14

C 0 7 D 311/30

C 0 7 D 311/60

C 0 7 D 407/04

C 0 7 D 409/04

C 0 7 D 455/04

C 0 9 K 11/06

// C 0 9 B 57/00

【F I】

H 0 5 B 33/14 B

C 0 7 D 311/30

C 0 7 D 311/60

C 0 7 D 407/04

C 0 7 D 409/04

C 0 7 D 455/04

C 0 9 K 11/06 6 3 5

C 0 9 B 57/00 N

C 0 9 B 57/00 P

C 0 9 B 57/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 5 月 12 日 (2005.5.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 3 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 3 3】

実施例 19

図 4 に示す構造を有する I T O 堆積ガラス基板（開口絶縁膜 I T O 基板）を用い、図 5 に示す構造を有する有機電界発光素子を、以下の方法で作成した。

まず、図 4 において、ガラス基板上 1 にインジウム・スズ酸化物（I T O）透明導電膜をスパッタ法にて 160 nm 堆積したものを、通常のリソグラフィ技術と塩酸エッチングを用いてパターンニングして、陽極 I T O 2 および陽極とは接していない位置に陰極取り出し部 I T O 8 を形成した。I T O をパターン形成した基板には、通常のリソグラフィ技術を用いて、陽極 I T O 2 上に 2 mm × 2 mm の絶縁膜開口部 9 を有する開口絶縁膜 10 を設け、図 4 に示す構造を有する開口絶縁膜 I T O 基板 11 を作成した。次いで開口絶縁膜 I T O 基板 11 を超純水による水洗、界面活性剤を用いた超音波洗浄、超純水による超音波洗浄、超純水による水洗の順で洗浄後、窒素ブローで乾燥させた。最後に紫外線オゾン洗浄を行った。

次に下記に示す組成の溶液を調製し、洗浄済みの開口絶縁膜 I T O 基板 11 に、下記条件にてスピンコート、乾燥し、厚さ 20 nm の陽極バッファ層溶液塗膜を形成した。

(陽極バッファー層溶液組成)

シクロヘキサノン	1 0 m l
高分子化合物 1	1 3 0 m g
電子受容性化合物 1	1 3 m g
スピナ回転数	1 5 0 0 r p m
スピナ回転時間	3 0 秒

(高分子化合物 1)

下記繰り返し単位のみからなる、単独重合体であり、重量平均分子量は 4 6 7 0 0 である。